

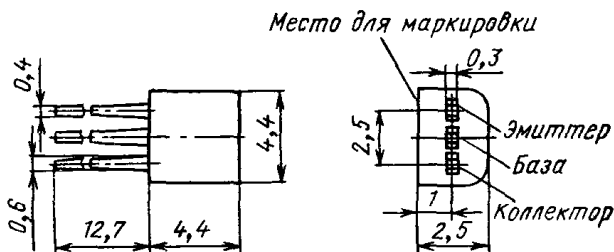
# КТ358А, КТ358Б, КТ358В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* уси-  
тельные высокочастотные маломощные

Предназначены для применения в усилительных и генераторны  
схемах радиоэлектронной аппаратуры

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами  
Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,2 г



## Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме  
с общим эмиттером при  $U_{КБ} = 10$  В,  $I_{Э} = 5$  мА не  
менее

КТ358А . . . . .	80 МГц
КТ358Б, КТ358В . . . . .	120 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой  
частоте не более . . . . . 500 пс

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмитте-  
ром при  $U_{КЭ} = 5,5$  В,  $I_{Э} = 20$  мА

КТ358А . . . . .	10–100
КТ358Б . . . . .	25–100
КТ358В . . . . .	50–280

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_{К} =$   
 $= 20$  мА,  $I_{Б} = 2$  мА не более . . . . . 0,8 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_{К} = 20$  мА,  
 $I_{Б} = 2$  мА не более . . . . . 1,1 В

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ} = 15$  В КТ358А,  
КТ358В, при  $U_{КБ} = 30$  В КТ358Б не более . . . . . 10 мкА

Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭБ} = 4$  В не более . . . . . 10 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

КТ358А, КТ358В . . . . .	15 В
КТ358Б . . . . .	30 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{БЭ} \leq$   
 $\leq 100$  Ом

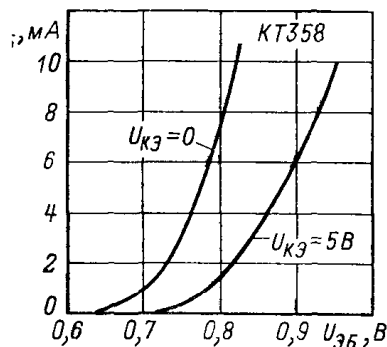
КТ358А, КТ358В . . . . .	15 В
КТ358Б . . . . .	30 В

Материал взят из источника:

Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . .	4 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	30 мА
Импульсный ток коллектора . . . . .	60 мА
Постоянная рассеиваемая мощность . . . . .	100 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность при $\tau_n \leq 1$ мкс . . . . .	200 мВт
Температура перехода . . . . .	393 К
Общее тепловое сопротивление . . . . .	0,7 К/Вт
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до 358 К

Примечание. Разрешается трехкратный изгиб выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 1 мм. При изгибе выводов должна быть обеспечена неподвижность выводов на участке от корпуса до места изгиба и исключена возможность передачи усилия на место присоединения вывода к корпусу, нарушения конструкции и герметичности транзистора.

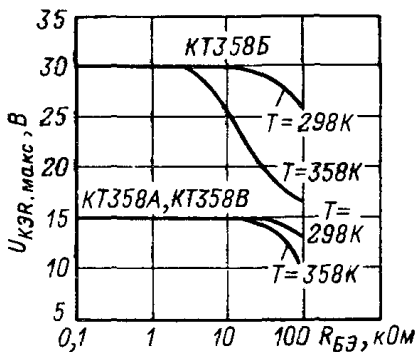
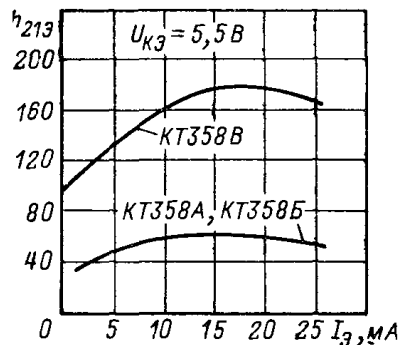
Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от лапчатого корпуса транзистора. Пайку производить в течение не более 10 с (температура пайки не должна превышать 523 К), приняв меры, исключаяющие возможность перегрева транзисторов



Входные характеристики.

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.



Материал взят из источника: